PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-196570

(43) Date of publication of application: 07.11.1984

(51)int.CI.

H01M 4/60

(21)Application number : 58-069935

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

22.04.1983

(72)Inventor:

KOBAYASHI MASAO

(54) CELL

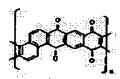
(57)Abstract:

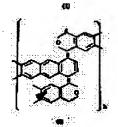
PURPOSE: To obtain a cell having high energy density, high

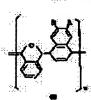
charge/discharge efficiency, long cycle life, low self-discharge rate and flat discharge voltage by employing polyacene quinone radical copolymer as an

electrode.

CONSTITUTION: Polyacene quinone radical copolymer is produced through reaction of acid anhydride and aromatic compound and has following different structure in accordance to acid anhydride and aromatic compound. Said polyacene quinone copolymer may be employed as film, powder, short fiber, etc. while other conductive material such as graphite, carbon black, acetylene black, metal powder, carbon fiber, etc. may be mixed or a metal mesh may be placed as a current collector. Conductive radical copolymer to be produced by doping said radical copolymer can be also employed for the positive or negative electrode.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭59—196570

⑤)Int. Cl.³
H 01 M 4/60

識別記号

庁内整理番号 2117-5H **劉公開** 昭和59年(1984)11月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

90電 池

願 昭58-69935

②特②出

願 昭58(1983)4月22日

⑫発 明

者 小林征男

東京都世田谷区玉川4-19-14

切出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門 1 丁目13番 9 号

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

郊代 理 人 弁理士 菊地精一

明 細 由

1. 発明の名称

雅 池

2. 特許請求の範囲

ポリアセンキノンラジカル乗合体または該サジカル乗合体にドーパントをドープして得られる電 専性ラジカル乗合体を正極および負極の電極に用いた電池。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジカル重合体にドーパントをドープして 得られる電導性ラジカル取合体を正極および負極 の篦飯に用いた電池に関する。

選移金属化合物と有機金属化合物とからなる かいわゆるチーグラー・ナッタ 触媒を用いてアセチレンを重合して得られるアセチレン高重合体はその電気伝導度が半導体領域にあることにより、能気・電子変子として有用な存機半導体材料であることはすでに知られている。

アセチレン高重合体の実用的成形品を製造する

方法としては、

- (f) 粉末状アセチレン腐重合体を加圧成形する 方法、および
- (中) 特殊な重合条件下で重合と同時に腰状に成形して、繊維状微結晶(フィブリル)構造を有し、かつ機械的強度の大きい膜状アセチレン高重合体を得る方法(特公昭 48-32581号)、が知られていた。

上記(1)の方法で得られる粉末状アセチレン高低合体成形品を BFa、BCla、HCL Cla、SO2、NO2、NO2、NO2、HCN、O2、NO 等の電子受容性化合物(アクセプター)で化学的に処理すると電気伝導度が最高 3 桁、上昇し、逆にアンモニアやメチルアミンのような電子供与性化合物(ドナー)で処理すると電気伝導度が最高 4 桁低下することもすでに知られている [D. J. Berets et al., Trans, Farady Soc., 64, 823 (1968)]。

また、何の方法で得られる膜状アセチレン高重合体に、 I₂、Ce₄、Br₂、ICe、IBr、AsEs、SbF₅、PR。 等の如き電子受容性化合物または Na、K。Li の如 き電子供与性化合物を化学的にドープすることによってアセチレン高重合体の電気伝導度を 10-8~ 10-3 ft 'cox' の広い範囲にわたつて自由にコントロールできることもすでに知られている[J.C.S. Chem. Commu., 578(1977), Phys, Rev, Lett., 39, 1098(1977), J. Am. Soc., 100, 1013(1975), J. Chem. Phys., 69, 5098(1978)]。このドープされた膜状アセチレン高重合体を一次電池の正極の材料として使用するという考えもすでに提案されている(Molecular Metals, NATO Conference Series, Series, Series VJ, 471-489(1978))。

一方、前記の化学的にドーピングする手法以外に、電気化学的に CeQ 、PF 、AsF 、AsF 、AsF 、CF、SO 、BF 等の如きアニオンおよび RN (R': アルキル 結)の如きカチオンをアセチレン高重合体にドープして P型および n 型の間導作アセチレン高重合体を製造する方法もすでに開発されている [J. C. S. Chem. Commu., 1979 594, C & EN Jan. 26, 39(1981). J. C. S. Chem. Commu.,

(3)

開放端電圧は 2.5 V、短絡電流密度は約 3 mA /cdであつた。

この電池は、電極として軽 R 化および料として軽 R 化および料として軽 R 化 が料として軽 R 化 が料として R を その R を を その R を として B を R を として は B を として は な として は な か と と が B に ま と い か に な が B に に な が B に な が B に な か で に か ま で に か ま で に か ま で に か ま で に か ま で に か ま で に か ま で に か の 性 能 は 必 す し も の で は な か つ た 。

本発明者は、上記の点に鑑みて、高エネルギー 密度を有し、サイクル寿命、充・放電効率及び放 電時の電圧の平担性が良好で、軽量化、小裂化が 容易で、かつ安価な電池を得るべく種々検討した

1981,317)。そして、 (中の方法で得られる 膜状で セチレン高重合体を用いて電気化学的ドーピング ・を利用した再光能可能な電池が報告されている (Paper Presented at the Internationnal Conferenceon Low Dimensional Synthetic Metals, Hersinger, Denmark, 10~15, August 1980). この電池は何の方法で得られる、例えば 0.1 mmの厚さのアセチレン高重合体フィルム二枚 をそれぞれ正・負の電極とし、ヨウ化リチウムを 含むテトラハイドロフラン溶液にこれを摂して9 Ⅴの直流電源につなぐとョウ化リチウムが電気分 解され、正極のアセチレン高重合体フィルムはヨ ウ素でドープされ、負額のアセチレン高重合体フ イルムはリチウムでドープされる。この電解ドー ピングが充電過程に相当することになる。ドープ された二つの電極に負荷をつなげばリチウムイオ ンとヨウ素イオンが反応して魅力が取り出せる。 この場合、開放端電圧 (Voc)は2.8 V、短絡電流 密度は5 mA / cml であり、電解液に過塩素酸リチ ウムのテトラハイドロフラン溶液を使用した場合、

(4)

結果、本発明を完成したものである。

即ち、本発明はポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジカル重合体にドーパントをドープして存られる電導性ラジカル重合体を正極および 負極の電極に用いた電池に関する。

本発明の方法によつて得られる電池は、前記した主鎖に共役二重結合を有する高分子化合物または設高分子化合物にドーパントをドープして得られる電導性高分子化合物を電極として用いた二次電池に比較して、(1)エネルギー密度が大きい。(II)放電時の電圧の平担性が良好である。側自己放電が少ない。(M)充・放電の繰り返しの雰命が長い、という利点を有する。

本発明で用いられるポリアセンキノンラジカル 重合体は、酸無水物と芳香族化合物との反応によ つて得られる。ここでいう酸無水物の具体例とし では、無水ビロメリット酸、無水フタル酸、無水 メリット酸等があげられ、また、芳香族化合物の 具体例としては、ピフエニル、ターフエニル、ナ フタレン、アンスラセン、フエナンスレン、ピレ ン、クリセン、トリフェニルクロロメタン、トリフェニルクロロン、、フルオロアンスレン、ジベンスレン、アクリジン、あげられるが、リック・カーを表して、できるが、これのではない。のではないことは言うまでもない。

(7)

R. D. Hartman, J. Polym, Sci., Part C. <u>17</u>, 187(1967) に記載されており、本発明で用いられるポリアセンキノンラジカル乗合体はこれらに記載されている方法によつて製造することができるが、必ずしもこれらの方法にのみ限定されるものではない。

本発明において用いられるポリアセンキノンラジカル重合体は膜状、粉末状、短機維状等、いずれの形態のものも用いることができる。

また、ポリアセンキノンラジカル 重合体に他の 適当な 導電材料、例えばグラフアイト、カーボン ブラック、アセチレンブラック、金属粉、炭素機 維等を混合することも、また、集電体として金属 (類)等を入れることも一向に発し支えない。

本発明の電池の正衡および負極の電極としては、 ポリアセンキノンラジカル重合体ばかりでなく該 ラジカル重合体にドーパントをドープして得られ る電導性ラジカル重合体も用いることができる。 ポリアセンキノンラジカル重合体へのドーパント のドーピング方法は、化学的ドーピングおよび電

(II)

これらポリアセンキノンラジカル銀合体の具体 例およびその製造法については H. A. Pohl. and.E. H. Englehardt, J. Phys. Chem., <u>66</u>, 2085(1962), J. W. Mason, H. A. Pohl and,

(8

気化学的ドーピングのいずれの方法を採用しても よい。

化学的にドーピングするドーパントとしては、 従来知られている種々の電子受容性化合物および 電子供与性化合物、即ち、(1)ョウ素、奥業および ヨウ化臭素の如きハロゲン、M五フツ化ヒ素、五 フッ化アンチモン、四フッ化ケイ素、五塩化リン、 五フツ化リン、塩化アルミニウム、奥化アルミニ ウム、フツ化アルミニウム、NbFs,TaFs, W Fa, FeCe。およびCdCe、等の如き金属ハロゲン化物、 伽硫酸、過塩素酸、硝酸、フルオロ硫酸、トリフ ルオロメタン硫酸およびクロロ硫酸の如きプロト ン酸、(IV)三酸化イオウ、二酸化窒素、ジフルオロ スルホニルパーオキシドの如き酸化剤、(V) AgCeQ、 (VI) テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメ タン、クロラニール、 2.3 - ジクロル・ 5.6 - ジ シアノパラベンゾキノン、 2.3 - ジプロム - 5.6 - ジシアノバラベンソキノン、(VII) CrO2 Cd2,

 $V \circ C \ell_a$, (VII) NO^+SbF_a , NO^+SbF_a , NO^+ABF_a , NO^+PF_a , NO^+PF_a , NO^+BF_a , NO^+BF_a , $NO^+C \ell O_A$, (IX) 2.

4.6 - トリニトロフエノール、 2.4.6 - トリニトロフエニルスルホン酸、 2.4.6 - トリニトロフエニルカルボン酸、 (X) Li, Na, K の如きアルカリ金属等をあげることができる。

一方、電気化学的にドーピングするドーパントとしては、(i) PFo、SbFo、ABFo、SbCGの如きVa 族の元素のハロゲン化物アニオン、BFoの如き IIIII 族の元素のハロゲン化物アニオン、1 (Io)、 Bro、CG の如きハロゲンアニオン、CGO の如 き過塩素酸アニオンなどの除イオン・ドーパント (いずれもP型電導性重合体を与えるドーパント として有効)および(i) Lit, Kt, Nat の如きアル カリ金属イオン、R,Nt (R: 炭素数 1~20の 炭化水素基)の如き 4級アンモニウムイオンなど の陽イオン・ドーパント(いずれもn型電導性所 合体を与えるドーパントとして有効)等をあげる ことができるが、必ずしもこれ等に限定されるも のではない。

上述の陰イオン・ドーパントおよび陽イオン・ ドーパントを与える化合物の具体例としては

(11)

~15のアリール (aryl) 基、mは X が酸素原子の とき 0 であり、 X が窒素原子のとき 1 である。 n は 0 または 1 ~ 5 である。)

または次式側もしくは側で扱わされるカルボニ ウム・カチオン:

および

(上式中、 R¹ 、 R² 、 R³ は水 楽原子 (R¹ 、 R² 、 R² は同時に水 楽原子であることはない) 、 炭 素 数 1 ~15 の アル キル 基、 アリル (ally1)蒸、 炭 素 数 6 ~15 の アリール (aryl) 基または - OR³ 基、 但 し R² は 炭 素 数 が 1 ~10 の アル キル 基また は 炭 素 数 6 ~15 の アリール (aryl) 著を 示し、 R⁴ は 水 楽原子 炭 素 数 が 1 ~15 の アル キル 善、 炭 素 数 6 ~15 の ア

LiPFo, LiSbFo, LiAsFo, LiCeO, NaI. NaPFo, NaSbFo, NaAsFo, NaCeO, KI, KPFo, KSbFo, KAsFo, KCeO, ((n-Bu), N)+·(AsFo)⁻, ((n-Bu), N)+·CeO, LiBFo, 等をあげることができるが必ずしもこれ等に限定されるものではない。これらのドーパントは一種類、または二種類以上を混合して使用してもよい。

前記以外の除イオン・ドーパントとしては HFデアニオンであり、また、前記以外の陽イオン・ドーパントとしては次式(J)で表わされるピリリウムまたはピリジニウム・カチオン:

$$X^+ - (R')_m \tag{I}$$

(式中、Xは酸素原子または窒素原子、Rは水素 原子または炭素数が $1 \sim 15$ のアルキル基、炭素数 $6 \sim 15$ のアリール (aryl) 据、 R^m はハロゲン原子 または炭素数が $1 \sim 10$ のアルキル基、炭素数が6

(12)

リール基である。〕 である。

用いられる ITc₂ フェオンは通常、下記の一般式 (IV) 、(V)または (VI):

$$R'_4 N \cdot HF_2$$
 (IV)
 $M \cdot HF_2$ (V)

$$(R'')_{n}$$
(VI)

(但し、上式中尺、尺がは水素原子または炭素数が1~15のアルキル基、炭素数6~15のアリール(ary1) 募、尺がは炭素数が1~10のアルキル基、炭素数6~15のアリール(ary1) 基、xは酸素原子または窒素原子、nは0または5以下の正の整数である。Mはアルカリ金属である〕で表わされる化合物(フツ化水素塩)を支持電解質として用いて適当な有機溶媒に溶解することによつて得られる。上式例、())および())で表わされ

る化合物の具体例としてはHIN·HF2、BunN·HF2、

Na·HF2、K·HF2、Li・HF2および

上記式(J)で表わされるピリリウムもしくはピリジニウムカチオンは、式(J)で表わされるカチオンと CCO、BF、ACCG、FeCG、SnCCG、PFG、PCG、SbFG、AsFGCF、SOS、HFS等のアニオンとの塩を支持 監解 倒として用いて適当な有機溶媒に溶解することによつて得られる。そのような塩の具体例としては

(15)

BF、ABCB、ABB、CE、FeCG、SuCBs、PF6、PCB、SbCBs、SbFs、CBOs、CF3 SOs 等をあげることができ、また、カルボニウム塩の具体例としては、例えば(Co Ho), C・BF, 、(CH3), C・BF, 、HCO・ABCB、HCO・BF、Co H3 CO・SnOBs 等をあげることができる。

ポリアセンキノンラジカル 重合体にドープされるドーパントの最は、高分子の繰り返し単位」モルに対して 2~300モルガ であり、好ましくは10~200モルダである。ドープしたドーバントの最が2 モル 5 未満でも 300モルダ を越えても良好な電 他性能を有する電池を得ることはできない。

ドーブ圏は電解の際に流れた電気量をコントロールすることによつて自由に制御することができる。一定電流下でも一定電圧下でもまた電流および電圧の変化する条件下のいずれの方法でドーピングを行なつてもよい。ドーピングの際の電流値、電圧値およびドーピング時間等は、用いるボリアセンキノンラジカル重合体の種類、 器さ密度、 ドーパントの種類、 電解液の種類、 要求される電気

等をあげることができる。

上記式伽または伽で扱わされるカルボニウム・カチオンの具体例としては(C_0H_0)。 C^+ 、(CH_3)。 C^+ 、 HC^+ 、 C_0H_3 C C をあげることができる。

これがらのカルボニウムカチオンは、それらと陰 イオンの塩(カルボニウム塩)を支持電解質とし て適当な有機溶媒に溶解することによつて得られ る。ここで用いられる陰イオンの代表例としては、

(16)

伝導度によつて異なるので一概に規定することは できない。

電気化学的ドーピングの際の電解液の有機溶媒と しては例えばエーテル類、ケトン類、ニトリル類、 アミン類、アミド類、硫黄化合物、塩素化炭化水 索顔、エステル類、カーポネート類、ニトロ化合 物、リン酸エステル系化合物、スルホラン系化合 物等を用いることができるが、これらのうちでも エーテル類、ケトン類、ニトリル類、塩素化炭化 水繋類、カーポネート類、スルホラン系化合物が 好ましい。これらの代表例としては、テトラヒド ロフラン、2ーメチルテトラヒドロフラン、1,4 - ジオキサン、アニソール、モノグリム、アセト ニトリル、プロピオニトリル、4-メチル-2-ペンタノン、プチロニトリル、 1,2 - ジクロロエ タン、ァープチロラクトン、ジメトキシエタン、 メチルフオルメイト、プロピレンカーポネート、 エチレンカーポネート、ジメチルホルムアミド、 シメチルスルホキシド、ジメチルチオホルムアミ ド、スルホラン、3-メチル-スルホラン、リン

酸トリメチル、リン酸トリエチルおよびこれらの 混合裕族等をあげることができるが、必ずしもこ れ等に限定されるちのではない。

本発明の観池において、ポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジカル重合体にドーパントをドープして得られる電導性ラジカル重合体を正極および負極として用いる場合、電池の電解液の支持電解質は前記の電気化学的ドーピングの際に用いたものと削機のものが用いられ、ドーピング方法も前記方法および従来公知の方法(J. C. S., Chem. Commu., 1981, 317)に準じて行なうことができる。

本発明の電池において用いられる電解質の譲度は用いるポリアセンキノンラジカル重合体の種類、光・放電条件、作動温度、電解質の種類および有機溶媒の種類等によつて異なるので一概に規定することはできないが、通常は 0.001~10モルノ & の範囲であり、過飽和の状態でも使用することができる。

本発明において、ポリアセンキノンラジカル重

(19)

蔵用パツテリーとして最適である。

以下に、実施例および比較例をあげて本発明を さらに詳細に説明する。

実施例 1

「ポリアセンキノンラジカル重合体の合成」ナフタレン:無水ビロメリット酸: Zincl, = 1
: 1 : 2 (モル比)の混合物を J. Phys. Chem., 66, 2085(1962)に記載されている方法と全く同様の方法で反応および後処理を行なつて(1)式の構造を有する黒色粉末のポリアセンキノンラジカル重合体を 得た。 得られた黒色粉末の爪合体を 10 ton/cm の圧力で加圧成形してシート状成形品を 得た。

[冠池実験]

前記の方法で得られたシート状ポリアセンキノンラジカル取合体より、幅が 0.5 cmで長さが 2.0 cmの 2 枚の小片を切り出して、それぞれ正極および負極とした。正極と負極の間の距離は 3 麻にした。 Et, N·BF, の濃度が 1.0 モルノ ℓ のスルホラン溶液を軽解液として用い、一定流下(0.5 mA

合体または該ラジカル重合体にドーパンをドープ して得られる阻避性ラジカル取合体は、電池の形 徳および負極の電極として用いられる。

本発明において必要ならばポリェチレン、ポリ ブロビレンのごとき合成樹脂の多孔賀膜や天然繊 維紙を瞬膜としても一向に差し支えない。

また、本発明の電池は薄い電池でよく、紙のように薄い電池でさえよく、複数の層を互いに積み重ねて直列または並列に互いに結合してもよく、 或いは一本の長い電池をそれ自体を巻くかまたは 螺旋状にしてもよい。

本発明のポリアセンキノンラジカル重合体または該ラジカル重合体にドーバントをドープして得られる電源性ラジカル重合体を正極および負極の電極として用いた電池は、高エネルギー密度を有し、充・放電効率が高く、サイクル寿命が長く、自己放電率が小さく、放電時の電圧の平担性が良好である。また、本発明の電池は、軽量、小型で、かつ高いエネルギー密度を有するからポータブル機器、電気自動車、ガソリン自動車および電力貯

(20)

ノ城)で70分間充電を行なつた(ドーピング量 8 モル系に相当する電気量)。 充電終了後、商ちに一定電流下(0.5 mA / cd) で放電を行ない、電圧が1.0 Vになつたところで再皮前配と同じ条件で充電を行なうという充・放電の繰り返し試験を行なつたところ、繰り返し回数が 307 回まで可能であつた。

10回目の繰り返し試験の結果から、活物包1kgに対するエネルギー密度(理論エネルギー密度)は273w・hr/kgであり、充・放電効率は94%であつた。また、放電時に電圧が1.5 Vまでに低下するまでに放電された電気量の全放電電気債に対する制合は92%であつた。

また、充電した状態で18時間放置したところ、 その自己放電率は5%であつた。

比較例 1

〔膜状アセチレン高重合体の製造〕

窒素雰囲気下で内容積 500ml の ガラス製反応容器に 1.7 mlのチタニウムテトラプトキサイドを加え、30mlのアニソールに溶かし、次いで 2.7 mlの

トリエチルアルミニウムを攪拌しながら加えて触 蝶常被を調製した。

この反応容器を液体窒素で冷却して、系中の窒素ガスを真空ポンプで排気した。次いで、この反応容器を - 78℃に冷却し、触媒溶液を静止したままで、 1 気圧の圧力の特製アセチレンガスを吹き込んだ。

直ちに、触媒常被要面で重合が起り、膜状のアセチレン高重合体が生成した。アセチレン導入後、49分で反応容器系内のアセチレンガスを排気して重合を停止した。選素雰囲気下で触媒常を注射器で除失した後、~78℃に保つたまま精製トルエン100㎡で5回繰り返し洗浄した。トルエンで解析でないでもの臓状アセチレン高重合体は、フィイブルが密に絡み合つた均一な膜状影神物であった。で、シス合量98%の膜状でもがでこの豚で85μπで、シス合量98%の膜セチレン高重合体を得た。また、この膜状でもり、その電気伝導度(直流四端子法)は20℃で3.2×10℃

 Ω^{-1} · cm^{-1} であつた。

〔電池実験〕

前記の方法で得られた膜状アセチレン高重合体を正極および負極の両極に用いた以外は、実施例1と全く同様の方法で電池の充・放電繰り返し実験を行なつたところ、繰り返し回数が198回回で充電が不可能となつた。試験後、膜状アセチレン高重合体を取り出してみると、腰は破壊されており、その一部を元素分析、赤外分光法により解析したところ、大巾な劣化を受けていた。また、電解を発色に着色していた。

10回目の繰り返し試験の結果から、この電池の理論エネルギー密度は 252 w・hr / kg で充・放電効率は 87%であつた。また、放電時に電圧が 1.5 Vに低下するまでに放電された電気量の全放電電気量に対する割合は 87%であつた。

また、光電した状態で 48 時間放倒したところ、 その自己放電率は 13 %であつた。

(23)

(24)